

03 氏名：岡本直樹

所属：電子物理工学分野

国際会議名称：Joint ISAF-ICE-EMF-IWPM-PFM meeting 2019

開催日：2019年7月14日~19日

開催場所：Swiss Tech Convention Center, Switzerland

発表タイトル：『Epitaxial growth of BiFeO₃ on Si substrate by sputtering method』

発表の概要：MEMS 応用にむけた Si 基板上への圧電体薄膜の作製、およびその特性向上に関する発表を行いました。

感想

昨年度に広島で開催された国際会議に参加しましたが、海外で開催される国際会議には初めて参加するという事で、少し不安がありました。実際参加してみると雰囲気は近いものがありましたが、やはり日本開催のものとはどこか違うように感じました。また著名な先生方が多く参加しており、その発表はとても刺激的なものでした。自身の発表については最終日ということもあり雰囲気も分かっていたので、ある程度リラックスして発表することができました。拙い英語ではありましたが無事発表を終えることが出来いい経験になりました。今回このような国際会議での発表の機会を与えていただいたことに深く感謝するとともに、この経験を通して得られたことを研究や学業に活かせるよう精進していきたいと思います。